

シリコン PNP エピタキシャル形

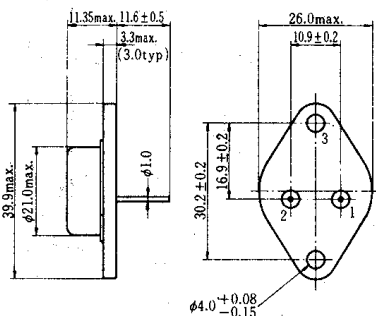
低周波電力増幅用

2SD629[Ⓜ]とコンプリメンタリペア

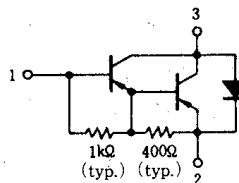
SILICON PNP EPITAXIAL

LOW FREQUENCY POWER AMPLIFIER

Complementary pair with 2SD629[Ⓜ]



1. ベース: Base
 2. エミッタ: Emitter
 3. コレクタ: Collector
(ケース) (Case)
- (Dimensions in mm)



(JEDEC TO-3)

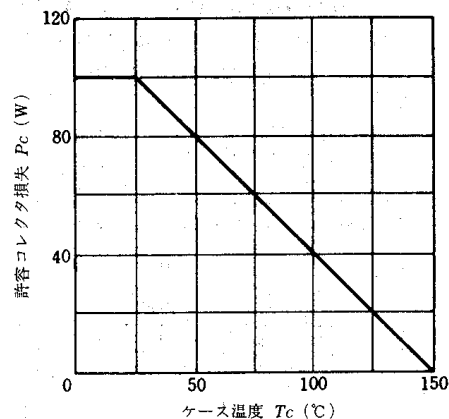
■絶対最大定格 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	2SB639 [Ⓜ]	Unit
コレクタ・ベース電圧	V_{CB0}	-100	V
コレクタ・エミッタ電圧	V_{CE0}	-100	V
エミッタ・ベース電圧	V_{EB0}	-7	V
コレクタ電流	I_C	-10	A
せん頭コレクタ電流	$i_{C(\text{peak})}$	-15	A
ベース電流	I_B	-2	A
許容コレクタ損失	P_C^*	100	W
接合部温度	T_j	150	$^\circ\text{C}$
保存温度	T_{stg}	-65~+150	$^\circ\text{C}$

* $T_C=25^\circ\text{C}$ における許容値

*Value at $T_C=25^\circ\text{C}$

許容コレクタ損失のケース温度による変化
MAXIMUM COLLECTOR DISSIPATION
CURVE



■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_a=25^\circ\text{C}$)

項目	Symbol	Test Condition	min.	typ.	max.	Unit
コレクタ・エミッタ維持電圧	$V_{CE0(\text{sat})}$	$I_C = -200\text{mA}$, $R_{BE} = \infty^*$	-100	—	—	V
エミッタ・ベース破壊電圧	$V_{(BR)EBO}$	$I_E = -50\text{mA}$, $I_C = 0$	-7	—	—	V
コレクタ遮断電流	I_{CBO}	$V_{CB} = -100\text{V}$, $I_E = 0$	—	—	-100	μA
	I_{CEO}	$V_{CE} = -80\text{V}$, $R_{BE} = \infty$	—	—	-1.0	mA
直流電流増幅率	h_{FE}	$V_{CE} = -3\text{V}$, $I_C = -5\text{A}^*$	1000	—	20000	
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(\text{sat})}(1)$	$I_C = -5\text{A}$, $I_B = -10\text{mA}^*$	—	—	-2.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(\text{sat})}(1)$		—	—	-2.0	V
コレクタ・エミッタ飽和電圧	$V_{CE(\text{sat})}(2)$	$I_C = -10\text{A}$, $I_B = -100\text{mA}^*$	—	—	-3.0	V
ベース・エミッタ飽和電圧	$V_{BE(\text{sat})}(2)$		—	—	-3.5	V
ターンオン時間	t_{on}	$I_C = -5\text{A}$, $I_{B1} = -I_{B2} = -10\text{mA}$	—	2	—	μs
ターンオフ時間	t_{off}		—	8	—	μs

*パルス測定

*Pulse Test